

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

บทนี้กล่าวถึงอุปกรณ์ เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในงานวิจัย ตลอดรวมถึงขั้นตอนและวิธีการทดลอง ตั้งแต่การเตรียมพิล์มน้ำงาไทยเนยม ไดออกไซด์ การศึกษาลักษณะเฉพาะทางกายภาพ และการศึกษาการฆ่าเชื้อ *E. coli* ของพิล์มน้ำงาไทยเนยม ไดออกไซด์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กรอบแนวคิดของงานวิจัย

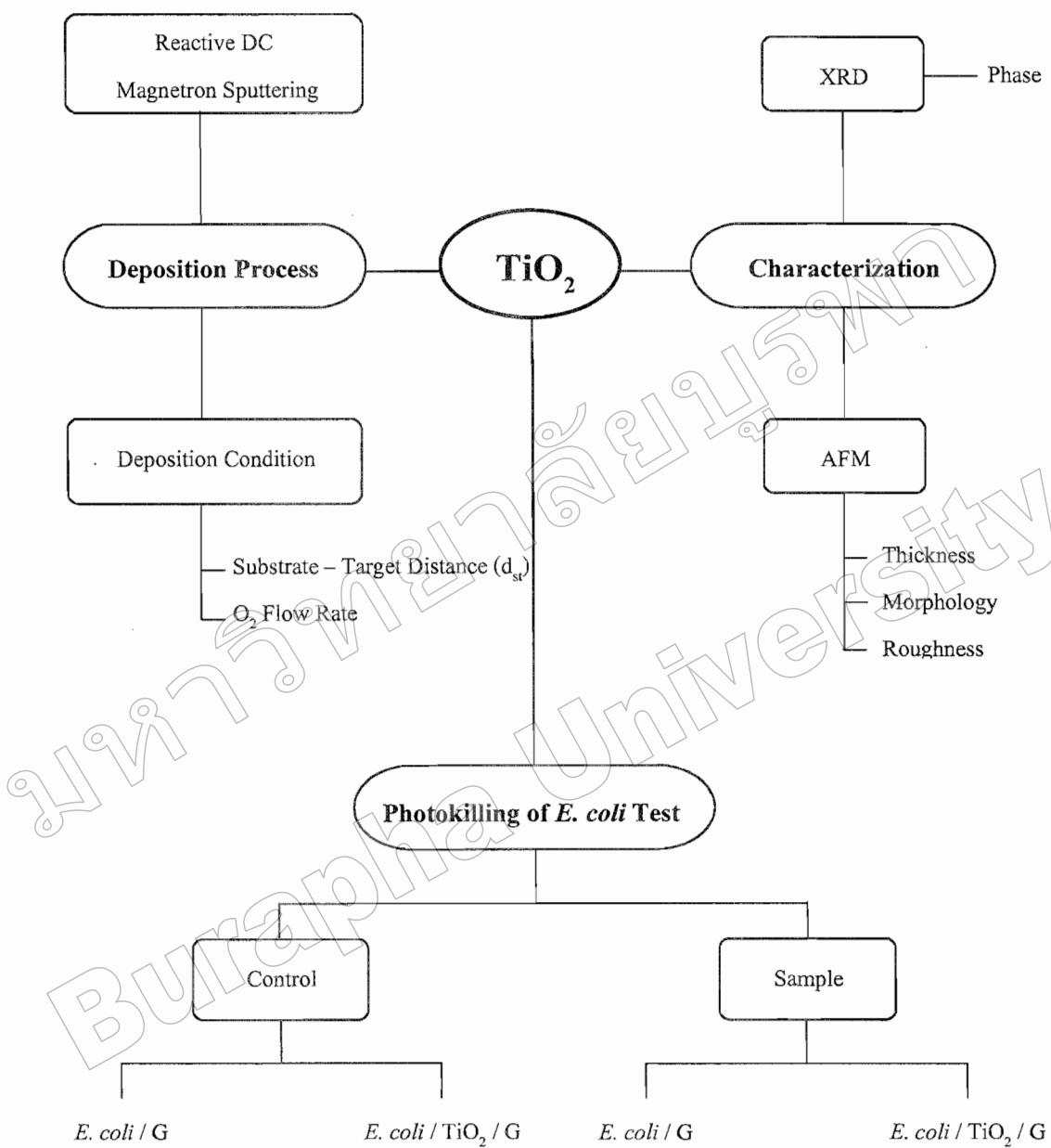
ผู้วิจัยแบ่งการดำเนินงานของวิทยานิพนธ์นี้เป็น 3 ส่วนคือ (1) การเตรียมพิล์มน้ำงาไทยเนยม ไดออกไซด์ (2) การหาลักษณะเฉพาะของพิล์มน้ำงาไทยเนยม ไดออกไซด์ และ (3) การศึกษาการฆ่าเชื้อ *E. coli* ของพิล์มน้ำงาไทยเนยม ไดออกไซด์ สรุปได้ดังนี้

การเตรียมพิล์มน้ำงาไทยเนยม ไดออกไซด์ เริ่มจากศึกษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ตัวแปรและขั้นตอนการผลิต ซึ่งวิทยานิพนธ์นี้ใช้การเคลือบด้วยวิธีรีแอคติฟ ดิซ์แมกนีตรอน สปีตเตอริง จากนั้นจึงทดลองเคลือบพิล์มน้ำงาไทยเนยม ไดออกไซด์ โดยศึกษาผลของระยะเวลาห่างเวลาการเคลือบกับวัสดุรองรับ และผลของอัตราไอลแก๊สออกซิเจนต่อโครงสร้างของพิล์มน้ำงาไทยเนยม ไดออกไซด์

การศึกษาลักษณะเฉพาะของพิล์มน้ำงาไทยเนยม ไดออกไซด์ที่เคลือบได้ด้วยเทคนิค XRD เพื่อศึกษาโครงสร้างผลึกขนาดผลึก ค่าคงที่แล็ตทิช (Lattice Constants) และใช้เทคนิค AFM เพื่อศึกษาความหนาและลักษณะพื้นผิว

ส่วนการศึกษาการฆ่าเชื้อ *E. coli* โดยการฉายแสงอัลตราไวโอเลต ผู้วิจัยจะนำพิล์มน้ำงาไทยเนยม ไดออกไซด์ที่เตรียมได้จากเงื่อนไขที่เหมาะสม ไปทดสอบความสามารถในการฆ่าเชื้อ *E. coli* โดยการนำเชื้อ *E. coli* ไปทดสอบบนกระจกที่ไม่เคลือบและเคลือบพิล์มน้ำงาไทยเนยม ไดออกไซด์ จากนั้นนำกระจกทั้งสองชนิดดังกล่าวมากระตุนด้วยแสงอัลตราไวโอเลต ซึ่งจะมีชุดควบคุมที่ไม่ผ่านการฉายแสงอัลตราไวโอเลต จากนั้นนำกระจกที่ผ่านการทดสอบแล้วมาศึกษาการเจริญของเชื้อ *E. coli* และตรวจนับปริมาณเชื้อ *E. coli* ที่เหลือรอดตาม เปรียบเทียบผลกับชุดควบคุม

สุดท้ายเป็นการอภิปรายผลของระยะห่างระหว่างเปลี่ยนการเคลือบกับวัสดุรองรับ ผลของอัตราไอลแก๊สออกซิเจนต่อโครงสร้างของพิล์มน้ำงาไทยเนยม ไดออกไซด์ และผลทดสอบการฆ่าเชื้อ *E. coli* ของพิล์มน้ำงาไทยเนยม ไดออกไซด์



ภาพที่ 3-1 กรอบแนวความคิดของการวิจัย

เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการทดลอง

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้งานวิจัยนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

1. การเตรียมพิล์มนางไทเทเนียม ไดออกไซด์

1.1 เครื่องเคลือบสุญญากาศระบบ รีแอคติฟ ดีซี เมกนิตรอน สปีดเตอร์ ที่ใช้งานวิจัยนี้คือ เครื่องเคลือบที่ใช้ในการวิจัยสร้างขึ้นโดยห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศ และพิล์มนาง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ภาพที่ 3-2)

1.2 วัสดุที่ใช้ในการทดลอง

1.2.1 เป้าสารเคลือบ (Target) เป็นเป้าไทเทเนียม มีความบริสุทธิ์ 99.97 %

1.2.2 วัสดุรองรับ (Substrate) มี 2 ชนิด คือ

- กระจกสไลด์ใช้เพื่อศึกษาความสามารถในการฆ่าเชื้อ *E. coli*

ของพิล์มนางไทเทเนียม ไดออกไซด์

- แผ่นซิลิโคนใช้เพื่อศึกษาโครงสร้างผลึก ขนาดผลึก ค่าคงที่แลตทิช ความหนา และลักษณะพื้นผิวของพิล์มนางไทเทเนียม ไดออกไซด์

1.2.3 แก๊ส (Gas) ประกอบด้วยแก๊ส 2 ชนิด คือ

- แก๊ส氩ร้อน (99.999%) เป็นแก๊สสปั๊ตเตอร์ (Sputtered Gas)

- แก๊สออกซิเจน (99.995%) เป็นแก๊สไวปัญกิริยา (Reactive Gas)

2. การหาลักษณะเฉพาะทางกายภาพของพิล์มนางไทเทเนียม ไดออกไซด์

2.1 X-Ray Diffractometer สำหรับศึกษาโครงสร้างผลึกงานวิจัยนี้ใช้เครื่อง X-Ray Diffractometer รุ่น Rint 2000 (Rigaku Corporation) ของภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.2 Atomic Force Microscope สำหรับศึกษาความหนา และลักษณะพื้นผิวงานวิจัยนี้ ใช้เครื่อง Atomic Force Microscope รุ่น Nanoscope IV (Veeco Instruments Inc.) ของศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุรินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. การศึกษาการฆ่าเชื้อ *E. coli* ของพิล์มนางไทเทเนียม ไดออกไซด์

3.1 การเตรียมเชื้อ *E. coli*

3.1.1 แบคทีเรีย *Escherichia coli* ATCC 25922 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย

3.1.2 อาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป บีท้อ Nutrient Broth (NB)

3.1.3 น้ำกลั่นประจารา เชื้อ (Distillation)

3.1.4 ไมโครพิปเปตต์ (Micropipette)

- 3.1.5 ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer Flask) ขนาด 250 มิลลิลิตร
- 3.1.6 หลอดทดลอง (Test Tube) ขนาด 150 มิลลิเมตร
- 3.1.7 หลอดไนโตรเช็นติฟิวเกจ (Microcentrifuge Tube)
- 3.1.8 ตะเกียงแอลกอฮอล์ (Alcohol Burner)
- 3.1.9 สำลี
- 3.1.10 ถุงมือยาง
- 3.1.11 ตู้แปลดเชื้อ (Laminar Flow Clean Bench)
- 3.1.12 เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความคุณอุณหภูมิ (Refrigerated Centrifuge)
ความเร็วรอบ 10,000 xg
- 3.1.13 หม้อนึ่งความดัน (Autoclave)
- 3.1.14 เครื่องเขย่าแนวราบแบบวงกลม (Shaker)
- 3.1.15 เครื่องสเปกตรอฟไฟটมิเตอร์ (Spectrometer)
- 3.2 การทดสอบความสามารถในการฆ่าเชื้อ *E. coli* ของฟิล์มบางไทเทนเนียม

道具กใช้ด้วย

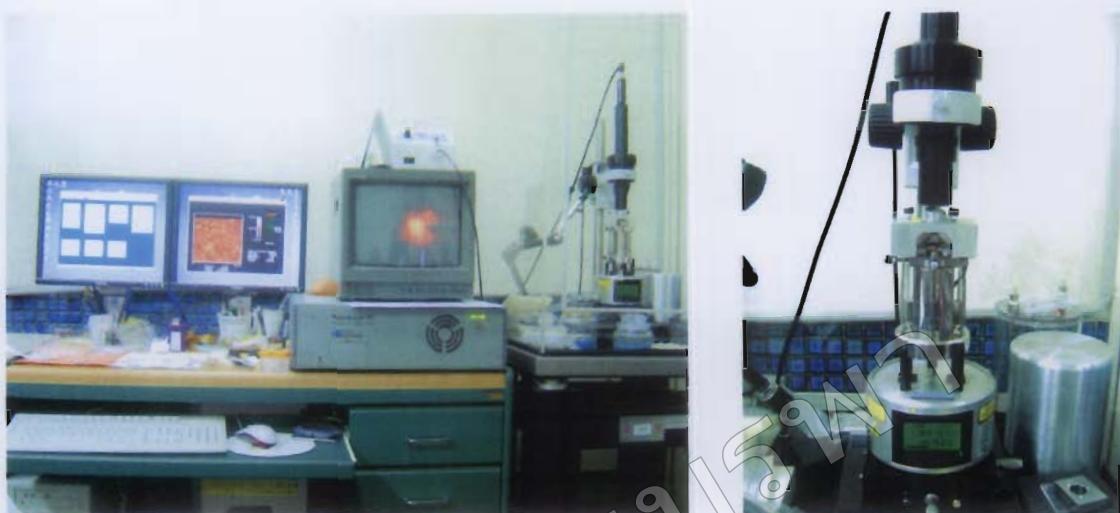
- 3.2.1 ฟิล์มบางไทเทนเนียม 道具กใช้ด้วยเคลือบได้
- 3.2.2 กระჯักสไลด์ (Slide)
- 3.2.3 แผ่นใส (Overhead Film)
- 3.2.4 จานอาหารเพาะเดี่ยงเชื้อ (Petri Dish)
- 3.2.5 แท่งแก้วสำหรับเคลียร์เชื้อแบบที่เรียบ (Spreader)
- 3.2.6 ปากคีบ (Forceps)
- 3.2.7 อาหารเดี่ยงเชื้อ Desoxycholate Agar
- 3.2.8 กล่องกำเนิดแสงอัลตราไวโอเลต
- 3.2.9 อุปกรณ์เครื่องแก้วอื่น ๆ



ภาพที่ 3-2 เครื่องเคลือบสุญญากาศระบบรีแอคติฟ ดีซี แมกนีตรอน สปีตเตอริง ที่ใช้ในงานวิจัย



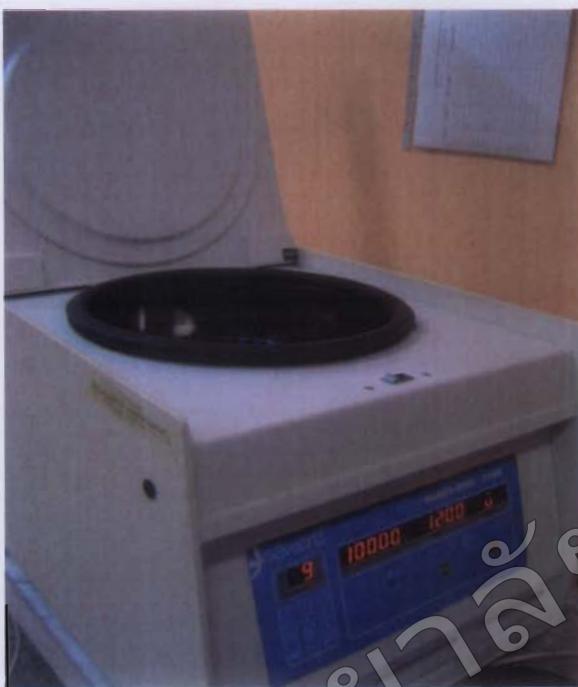
ภาพที่ 3-3 เครื่อง X-Ray Diffractrometer (XRD)



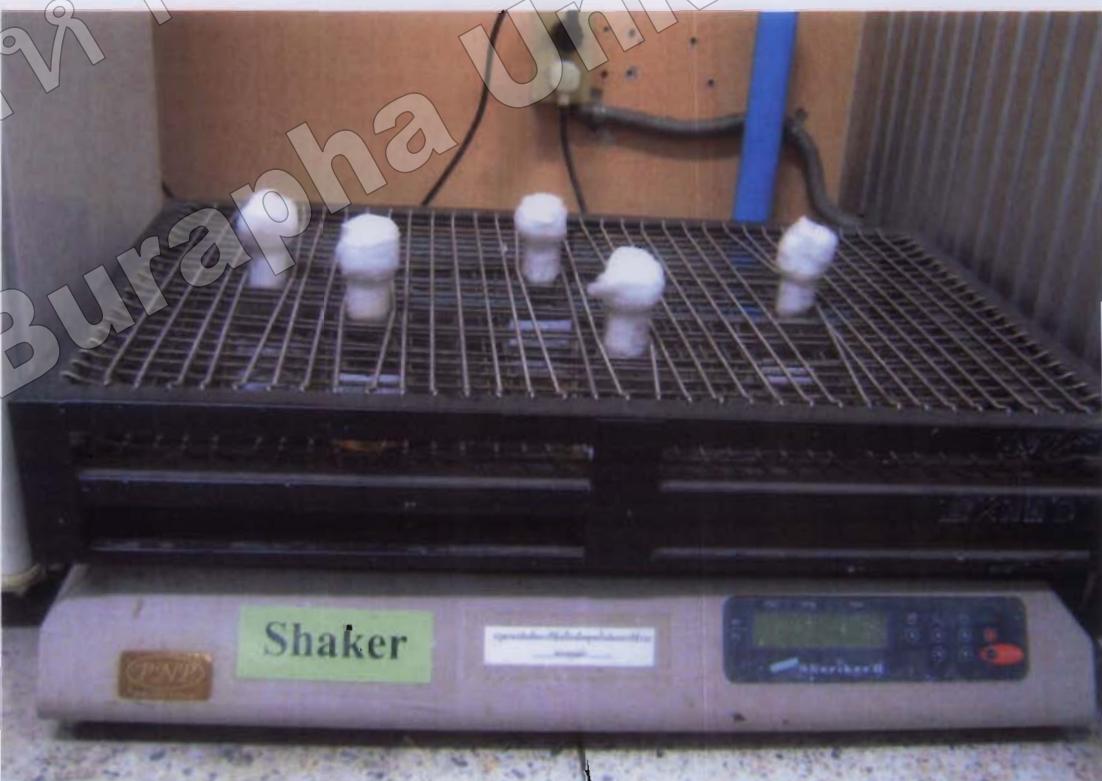
ภาพที่ 3-4 เครื่อง Atomic Force Microscope (AFM)



ภาพที่ 3-5 ตู้ป้องกันเชื้อ



ภาพที่ 3-6 เครื่องหมุนเวียนแบบควบคุมอุณหภูมิ



ภาพที่ 3-7 เครื่องเขย่าแนวราบแบบวงกลม



ภาพที่ 3-8 อุปกรณ์และเครื่องแก้วที่ใช้ในการทดลอง



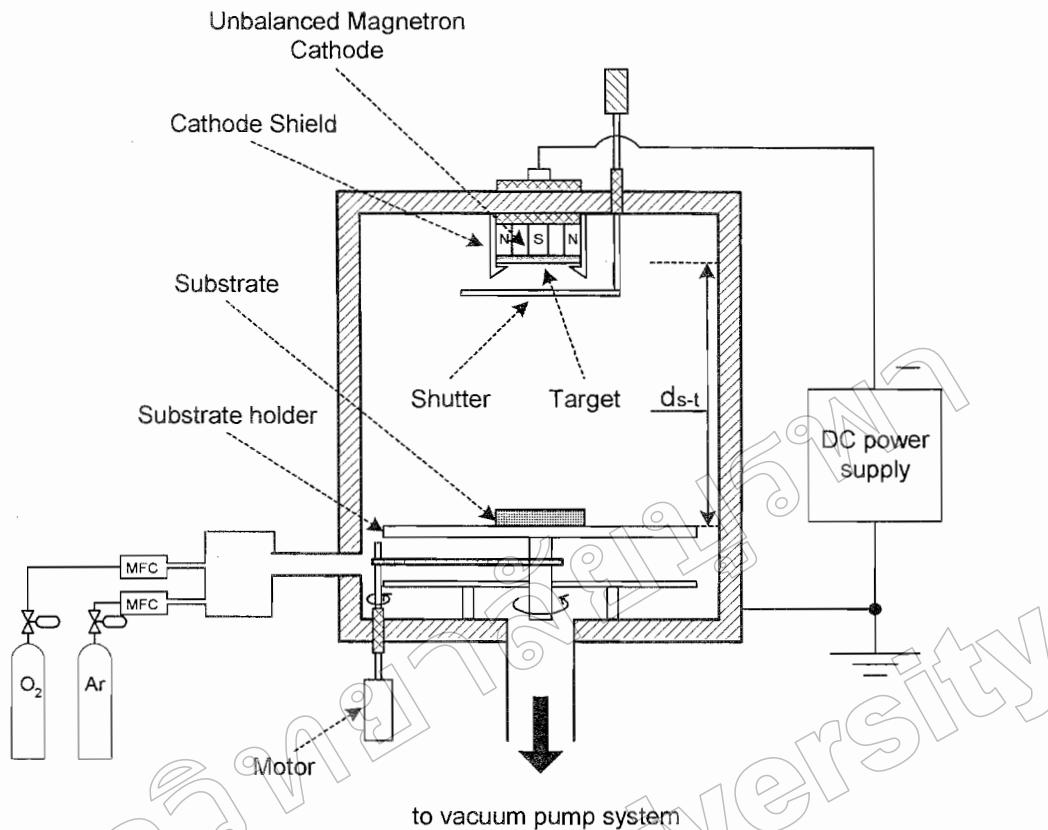
ภาพที่ 3-9 แบคทีเรีย *Escherichia coli* ATCC 25922

จากกรนวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย

เครื่องเคลือบฟิล์มบางระบบ รีแอคตีฟ ดีซี สปั๊ตเตอริง

ฟิล์มบางไทเทนเนียมไดออกไซด์ในงานวิทยานิพนธ์นี้ เตรียมได้จากเครื่องเคลือบในสุญญากาศระบบ ดีซี อันบาลานซ์ แมกนีตرون สปั๊ตเตอริง (ภาพที่ 3-10) ด้วยเทคนิครีแอคตีฟ สปั๊ตเตอริง ซึ่งเป็นกระบวนการภายในให้สภาวะสุญญากาศ ดังนี้ เพื่อให้ฟิล์มบางที่ได้มีคุณภาพและสมบัติตามที่ต้องการ จะต้องลดความดันภายในภาชนะสุญญากาศให้อยู่ในระดับ 10^{-5} mbar ส่วนประกอบของเครื่องเคลือบระบบสปั๊ตเตอริงในงานวิจัยนี้ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของระบบสุญญากาศ (Vacuum System) และส่วนของระบบเคลือบ (Coating System) รายละเอียดดังนี้

1. ส่วนระบบสุญญากาศ ประกอบด้วย ห้องเคลือบทรงกระบอกทำจากสแตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 310.0 mm สูง 370.0 mm ระบบเครื่องสูบสุญญากาศประกอบด้วย เครื่องสูบแบบเพร์โไอแบบบรรยายความร้อนด้วยน้ำและมีเครื่องสูบกล โรตารีเป็นเครื่องสูบท้าย การวัดความดันภายในภาชนะสุญญากาศใช้มาตรวัดความดันของ Balzers รุ่น TPG300 โดยใช้ หัววัดแบบพิรานี รุ่น TPR010 และหัววัดแบบเพนนิ่งรุ่น IKR050
2. ส่วนของระบบเคลือบ เป็นส่วนเตรียมฟิล์มบางไทเทนเนียมไดออกไซด์ ประกอบด้วย แมกนีตرونค่าโทด 2 หัว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 54.0 mm บรรยายความร้อนด้วยน้ำติดตั้ง เป้าไทเทนเนียม (99.97%) ที่ค่าโทด พร้อมภาคจ่ายไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง ใช้แก๊สอาร์กอน ความบริสุทธิ์สูง (99.999%) เป็นแก๊สสปั๊ตเตอร์ ใช้แก๊สออกซิเจนความบริสุทธิ์สูง (99.995%) เป็นแก๊สไวนิลคลอเรต สำหรับการจ่ายแก๊สอาร์กอนและแก๊สออกซิเจนในกระบวนการเคลือบควบคุมด้วย Mass Flow Controller ของ MKS type247D



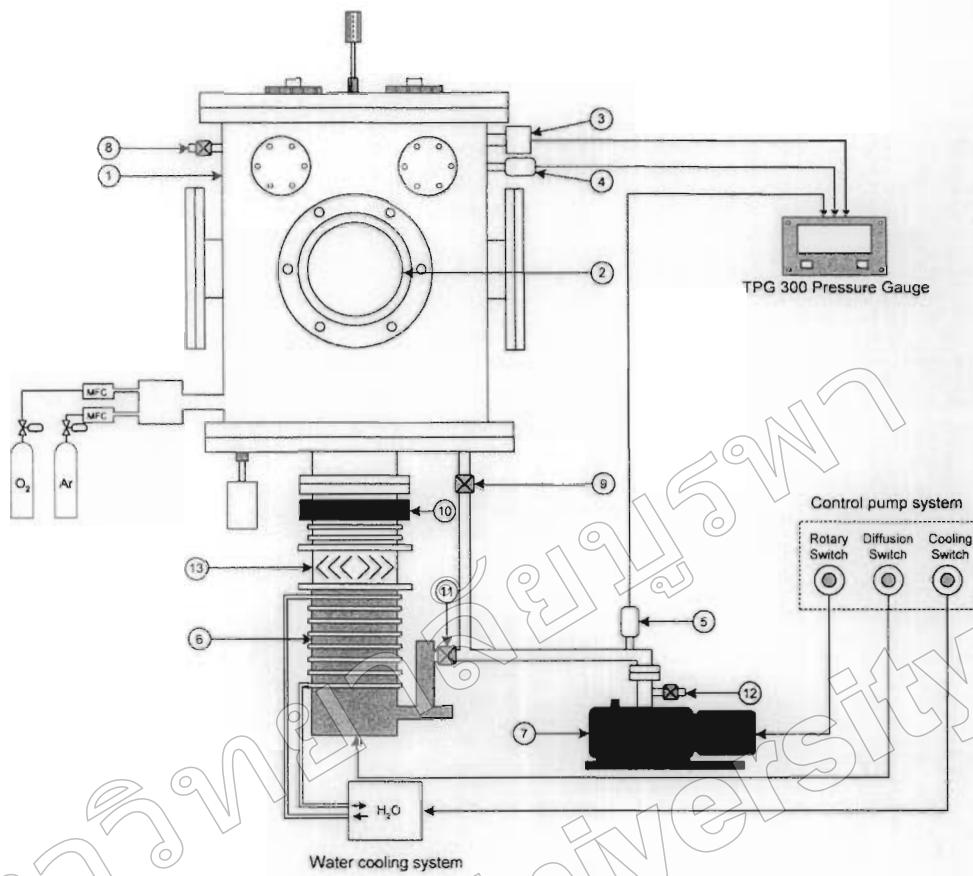
ภาพที่ 3-10 ไดอะแกรมของเครื่องเคลือบ

การสร้างสภาวะสุญญากาศ

ก่อนทำการเคลือบฟิล์มด้วยวิธีสปัตเตอริ่ง ต้องทำการดันในภาชนะสุญญากาศให้อยู่ในสภาวะสุญญากาศที่ระดับสุญญากาศสูง (High Vacuum) ความดันประมาณ 10^{-3} - 10^{-5} mbar เพื่อลดการรบกวนของฟิล์มที่เคลือบได้เนื่องจากการคงค้างของแก๊สในภาชนะสุญญากาศ (Residual Gas) การสร้างสภาวะสุญญากาศจะใช้ระบบเครื่องสูบสุญญากาศ ประกอบด้วยเครื่องสูบแบบแพร์โไอ (Diffusion Pump) หนุนหลังด้วยเครื่องสูบกลไครต์ (Rotary Pump) ที่ต่อเข้ากับภาชนะสุญญากาศ ด้วยหัวและมีวัล์วควบคุมการปิด-เปิด (ภาพที่ 3-11) โดยในตอนต้นจะใช้เครื่องสูบกลไครต์เพื่อลดความดันในภาชนะสุญญากาศจากความดันบรรยากาศเป็นความดันต่ำประมาณ 10^{-2} mbar ตอนนี้จะใช้เครื่องสูบแบบแพร์โไอ เพื่อลดความดันในภาชนะสุญญากาศจาก 10^{-2} mbar ให้ลดลงอยู่ในช่วงความดัน 10^{-5} mbar

สำหรับขั้นตอนการสร้างภาวะสุญญาการ มีดังนี้

1. ตรวจเช็ค瓦ล์วายาน (หมายเลข 9) วาล์วทัย (หมายเลข 11) และวาล์วสุญญาการสูง (หมายเลข 10) ให้อยู่ในสภาพปิดทั้งหมด
2. เปิดสวิตช์หลัก เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้แก่ระบบต่าง ๆ ของเครื่อง เช่น ระบบวัดความดัน และระบบควบคุมการทำงานของระบบเครื่องสูบสุญญาการ เป็นต้น หลังจากนั้นเปิดสวิตช์ Rotary เพื่อให้เครื่องสูบกลโตรารี (หมายเลข 7) ทำงาน
3. เริ่มสูบอากาศจากเครื่องสูบแบบแพร์-ไอ โดยใช้เครื่องสูบกลโตรารี โดยปิดวาล์วทัย เพื่อให้เครื่องสูบกลโตรารีสูบอากาศออกจากเครื่องสูบแบบแพร์-ไอ (หมายเลข 6) จนความดันในเครื่องสูบแบบแพร์-ไอ เมื่ออ่านจากพิรานีเกจ (หมายเลข 4) มีค่า้อยกว่า 10^{-2} mbar ซึ่งเป็นความดันที่เครื่องสูบแบบแพร์-ไอ สามารถทำงานได้ พร้อมทั้งเปิดสวิตช์ Diffusion เพื่อให้ตัวทำความร้อนของเครื่องสูบแบบแพร์-ไอทำงานเริ่มต้นนำมัน ใช้ประมาณ 20 นาที
4. ในระหว่างการต้มน้ำมันนำวัสดุรองรับที่ต้องการเคลือบวงในภาชนะสุญญาการ โดยก่อนวางวัสดุรองรับต้องตรวจความดันในภาชนะสุญญาการ ยังคงอยู่ในสภาพเป็นสุญญาการ หรือไม่ ถ้ายังคงเป็นสุญญาการให้ทำการเปิดวาล์วปล่อย เพื่อให้อากาศเข้าสู่ภาชนะสุญญาการ จนความดันในภาชนะสุญญาการเท่ากับความดันบรรยายกาศ หลังจากนั้นทำการเปิดฝาครอบภาชนะสุญญาการออก นำวัสดุรองรับที่ต้องการเคลือบไปวาง ปิดฝาครอบและปิดวาล์วปล่อยให้สนิท
5. สร้างสภาพสุญญาการขั้นต้นในภาชนะสุญญาการโดยใช้เครื่องสูบกลโตรารี โดยการปิดวาล์วทัย แล้วปิดวาล์วายานเพื่อให้เครื่องสูบกลโตรารีสูบอากาศออกจากภาชนะสุญญาการ จนความดันในภาชนะสุญญาการ มีค่าประมาณ 10^{-2} mbar เมื่ออ่านความดันจากมาตรวัดความดันแบบช่วงกว้าง (หมายเลข 3)
6. เมื่อต้มน้ำมันครบ 20 นาที ทำการสร้างสภาพสุญญาการสูง ในภาชนะสุญญาการ ด้วยเครื่องสูบแบบแพร์-ไอ โดยปิดวาล์วทัย แล้วเปิดวาล์วทัย หลังจากนั้นเปิดวาล์วสุญญาการสูง เพื่อให้เครื่องสูบแบบแพร์-ไอสูบอากาศออกจากภาชนะสุญญาการเพื่อทำความดันในภาชนะสุญญาการให้อยู่ในระดับสภาพสุญญาการสูง หรืออยู่ในช่วง $10^{-5} - 10^{-6}$ mbar
7. จับเวลาและรอจนความดันในภาชนะสุญญาการมีค่าประมาณ 5×10^{-5} mbar ซึ่งกำหนดให้เป็นค่าความดันพื้น (P_b) ก่อนเริ่มกระบวนการเคลือบพิล์มนบาง ให้เทนเนียม ไดออกไซด์

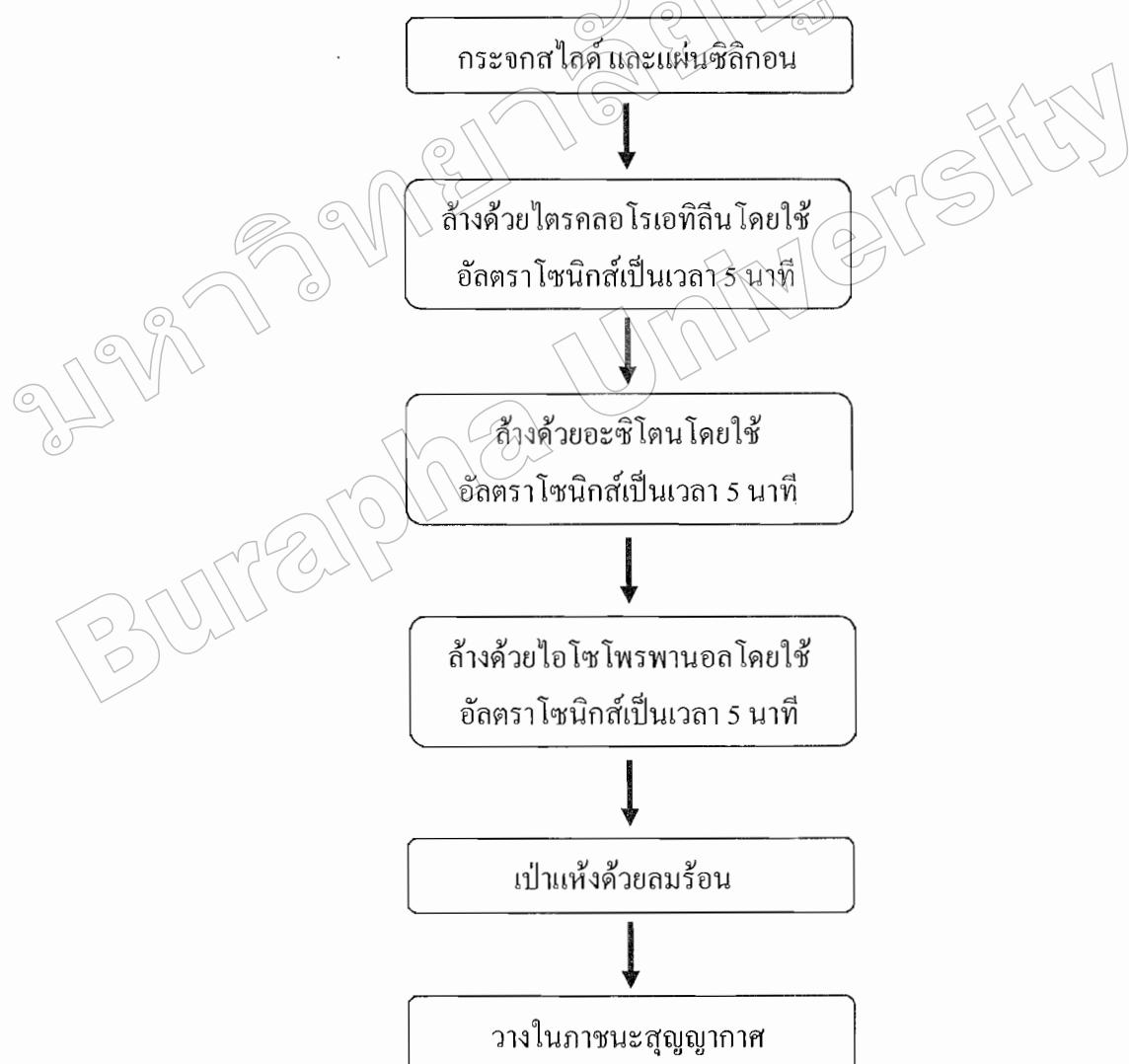


ภาพที่ 3-11 ไดอะแกรมระบบเครื่องสูบสูญญากาศของระบบเคลือบสปัตเตอริ่ง

- | | |
|---|---|
| 1. ภาชนะสูญญากาศ (Vacuum Chamber) | 2. หน้าต่าง (Window) |
| 3. มาตรวัดความดันเพนning (Penning Gauge) | 4. มาตรวัดความดันพิรานี (Pirani Gauge) |
| 5. มาตรวัดความดันแบบพิรานี (Pirani Gauge) | 6. เครื่องสูบแบบแพร์ฟิวชัน (Diffusion Pump) |
| 7. เครื่องสูบกล โรตารี (Rotary Pump) | 8. วาล์วปล่อย (Vent Valve) |
| 9. วาล์วหายน (Roughing Valve) | 10. วาล์วสูญญากาศสูง (High Vacuum Valve) |
| 11. วาล์วท้าย (Backing Valve) | 12. วาล์วปล่อย (Vent Valve) |
| 13. แบฟเฟลล์ (Baffle) | |

การเตรียมวัสดุรองรับสำหรับการเคลือบฟิล์ม

ทั้งนี้ก่อนนำวัสดุรองรับมาเคลือบฟิล์มต้องนำมาทำความสะอาดเพื่อขัดสิ่งสกปรก ได้แก่ คราบฝุ่น ไขมันสารอินทรีย์ต่าง ๆ ก่อน ซึ่งจะทำให้ได้วัสดุรองรับที่ได้มีความสะอาด ทำให้ฟิล์มที่เคลือบยึดติดแน่นลงบนผิวน้ำของวัสดุรองรับ สำหรับการทำความสะอาดวัสดุรองรับ เริ่มจากนำวัสดุรองรับไปล้างด้วยไตรคลอโรเอทิลีน (Trichloroethylene) โดยใช้อัลตราโซนิกส์ เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นนำไปล้างด้วยอะซิโตน โดยใช้อัลตราโซนิกส์เป็นเวลา 5 นาที แล้วนำไปล้างต่อด้วยไอโซโพรพานอล (Isopropanol) โดยใช้อัลตราโซนิกส์อีก 5 นาที นำวัสดุรองรับขึ้นด้วย คิมคีบ เป่าแห้งด้วยลมร้อนให้แห้ง จากนั้นนำวัสดุรองรับใส่เข้าในภาชนะสูญญากาศเพื่อรอการเคลือบ ดังแสดงในภาพที่ 3-12



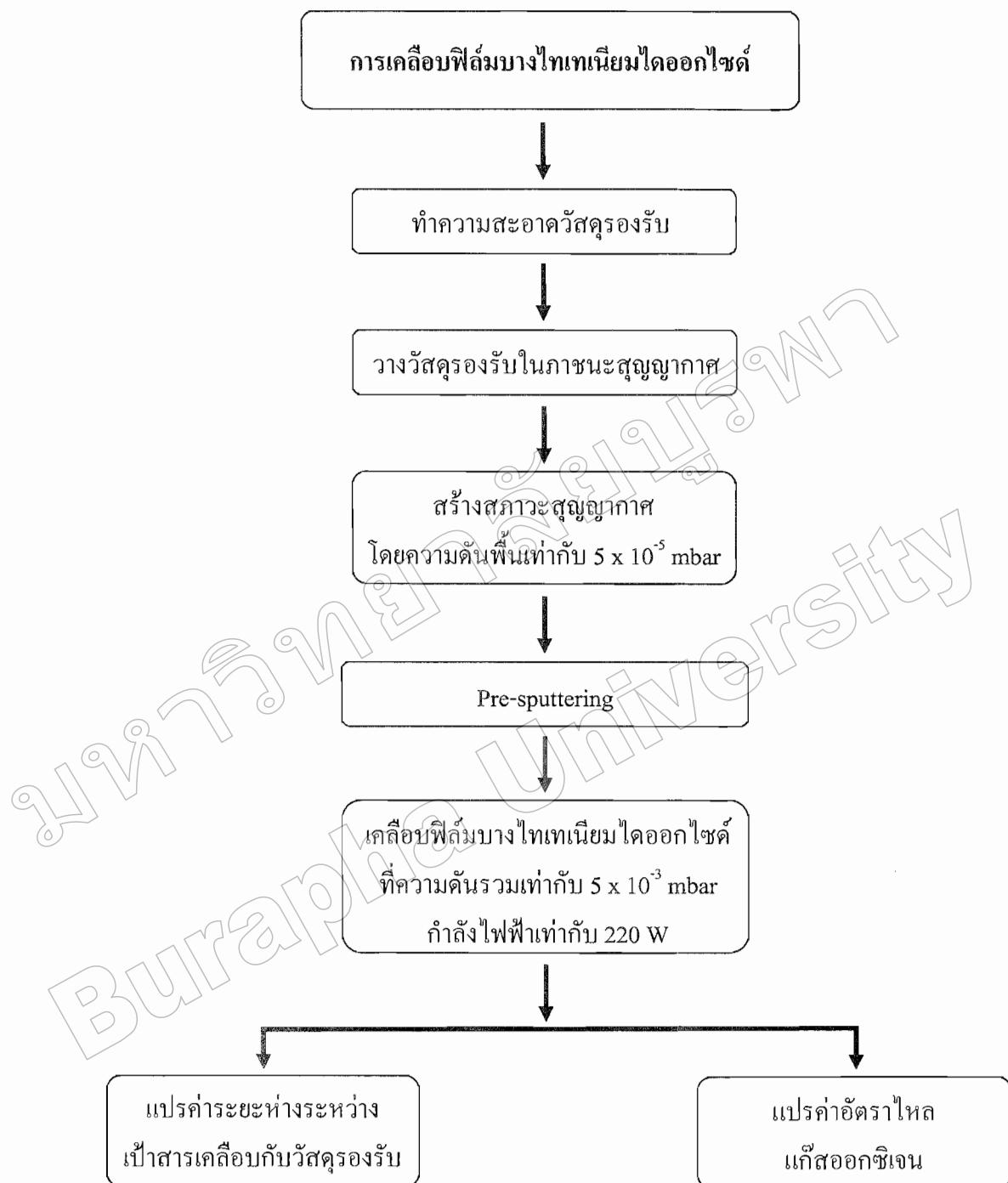
ภาพที่ 3-12 ขั้นตอนการล้างวัสดุรองรับ

การเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมโดยอุตสาหกรรม

การเคลือบฟิล์มบางในภาชนะสูญญากาศด้วยวิธีรีแอคติฟ ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริง มีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงถูกติดตั้งเข้ากับระบบเคลือบโดยต่อ ศักย์ไฟฟ้าลบเข้ากับขั้วคาโทดและต่อศักย์ไฟฟ้าบวก (Ground) กับภาชนะสูญญากาศ เป้าไทเทเนียม จะถูกติดตั้งกับขั้วคาโทด โดยด้านบนของคาโทดจะต่อ กับระบบไอลเวียนน้ำเย็นเพื่อใช้ระบายความร้อนที่เกิดขึ้นบริเวณคาโทดจากการสปัตเตอร์ของไอลอนอาร์กอนที่บริเวณผิวน้ำเป้าสารเคลือบ ส่วนวัสดุรองรับถูกวางบนแผ่นรองรับที่ติดตั้งบนแท่นวางที่สามารถเคลื่อนที่ขึ้ลงได้ โดยชัตเตอร์ (Shutter) ใช้สำหรับกันระหว่างวัสดุรองรับกับเป้าสารเคลือบ เพื่อป้องกันการเคลือบผิววัสดุรองรับ ในระหว่างกระบวนการทำความสะอาดหน้าเป้า (Pre-Sputtering) และอุปกรณ์ Control Unit ที่เชื่อมต่อกับ Mass Flow Controller (MFC) ใช้ชั้งคัยการทำงานของเครื่องควบคุมการปล่อยแก๊สอย่างละเอียด เพื่อควบคุมอัตราการไอลของแก๊สอาร์กอนและแก๊สออกซิเจน ที่เข้าสู่ภาชนะสูญญากาศ โดยค่าอัตราการไอลของแก๊สจะมีหน่วยเป็น Standard Cubic Centimeter per Minute at STP (scm)

ขั้นตอนในการเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมโดยอุตสาหกรรม รายละเอียดดังนี้

1. นำวัสดุรองรับที่ต้องการเคลือบวางไว้บนแท่นวางวัสดุรองรับ ปิดชัตเตอร์หน้าเป้าไทเทเนียม แล้วปิดฝาภาชนะสูญญากาศ
2. ลดความดันภายในภาชนะสูญญากาศท่ากับ 5×10^{-5} mbar กำหนดเป็นค่าความดันพื้น (P_b) ของระบบก่อนทำการเคลือบฟิล์ม บันทึกค่าความดัน P_b ที่อ่านได้
3. ทำความสะอาดหน้าเป้าสารเคลือบด้วยกระบวนการ Pre-Sputtering เป็นเวลา 3 นาที
4. ขั้นตอนนี้เป็นการเคลือบฟิล์มโดยเริ่มจากการปล่อยแก๊สอาร์กอน และแก๊สออกซิเจน เข้าสู่ภาชนะสูญญากาศ ตามค่าที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการทดลอง
5. จ่ายศักย์ไฟฟ้าลบให้แก่คาโทด จนเกิดโกลว์ดิสชาร์จ (ชัตเตอร์ปิดคงปีกอยู่) เมื่อความต่างศักย์ไฟฟ้าที่จ่ายให้คาโทดและกระแสคาโทดที่วัดได้ไม่เปลี่ยนแปลง จะเริ่มการเคลือบฟิล์มบาง โดยเปิดชัตเตอร์ที่ปิดหน้าเป้าออก เพื่อเริ่มกระบวนการเคลือบฟิล์มลงบนวัสดุรองรับ พร้อมทั้งบันทึกค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (ΔV) ค่ากระแสไฟฟ้า (I) และความดันรวม (P) ที่เกิดขึ้นขณะเริ่มเคลือบฟิล์ม และทำการเคลือบฟิล์ม ตามเวลา (t) ที่กำหนด
6. หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเคลือบฟิล์ม ปิดแหล่งจ่ายไฟ ปิดแก๊สอาร์กอน และแก๊สออกซิเจน ปล่อยให้อากาศเข้าไปในภาชนะสูญญากาศ เพื่อนำวัสดุรองรับออกมานอก



ภาพที่ 3-13 การเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมโดยอุกไชด์

การศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางไทเทเนียมโดยอุ่นไฮด์

การศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางไทเทเนียมโดยอุ่นไฮด์ในงานวิจัยนี้ เป็นการนำฟิล์มบางไทเทเนียมโดยอุ่นไฮด์ที่เคลือบได้ มาศึกษาโครงสร้างผลึกขนาดผลึก ค่าคงที่แลตทิซลักษณะพื้นผิว และความหนา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของฟิล์มบางไทเทเนียมโดยอุ่นไฮด์ นำวัสดุรองรับที่เป็นแผ่นซิลิกอนที่ผ่านการเคลือบแล้ว มาทำการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง X-Ray Diffractometer เพื่อหาโครงสร้างผลึกของฟิล์มไทเทเนียมโดยอุ่นไฮด์ที่ได้ โดยใช้ $Cu-k\alpha$ เป็นแหล่งกำเนิดรังสีเอกซ์ ใน Mode Low Angle กำหนดมุมวัดอยู่ในช่วง $20^\circ - 65^\circ$ สเปกตรัมที่วัดได้นำไปเปรียบเทียบกับรูปแบบการเลี้ยงบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางไทเทเนียมโดยอุ่นไฮด์ตามฐานข้อมูลอ้างอิงของแฟ้ม JCPDS

2. การหาขนาดผลึกของฟิล์มบางไทเทเนียมโดยอุ่นไฮด์ สำหรับการหาขนาดผลึกของฟิล์มบางไทเทเนียมโดยอุ่นไฮด์ สามารถหาได้จากรูปแบบโครงสร้างผลึกของฟิล์มบางที่เคลือบได้ จากการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของฟิล์มบางไทเทเนียมโดยอุ่นไฮด์ โดยใช้ Scherrer Equation ในการคำนวณหาขนาดผลึกของฟิล์มบางไทเทเนียมโดยอุ่นไฮด์ที่ได้หลังการเคลือบ

3. การหาค่าคงที่แลตทิซของฟิล์มบางไทเทเนียมโดยอุ่นไฮด์ สำหรับการค่าคงที่แลตทิซของฟิล์มบางไทเทเนียมโดยอุ่นไฮด์ สามารถหาได้จากรูปแบบโครงสร้างผลึกของฟิล์มบางที่เคลือบได้จากเครื่อง X-Ray Diffractometer โดยใช้สมการการหาระยะห่างระหว่างระนาบผลึกของฟิล์มที่มีโครงสร้างแบบเตตระโภนอล ในการคำนวณหาค่าคงที่แลตทิซของฟิล์มบางไทเทเนียมโดยอุ่นไฮด์ที่ได้หลังการเคลือบ

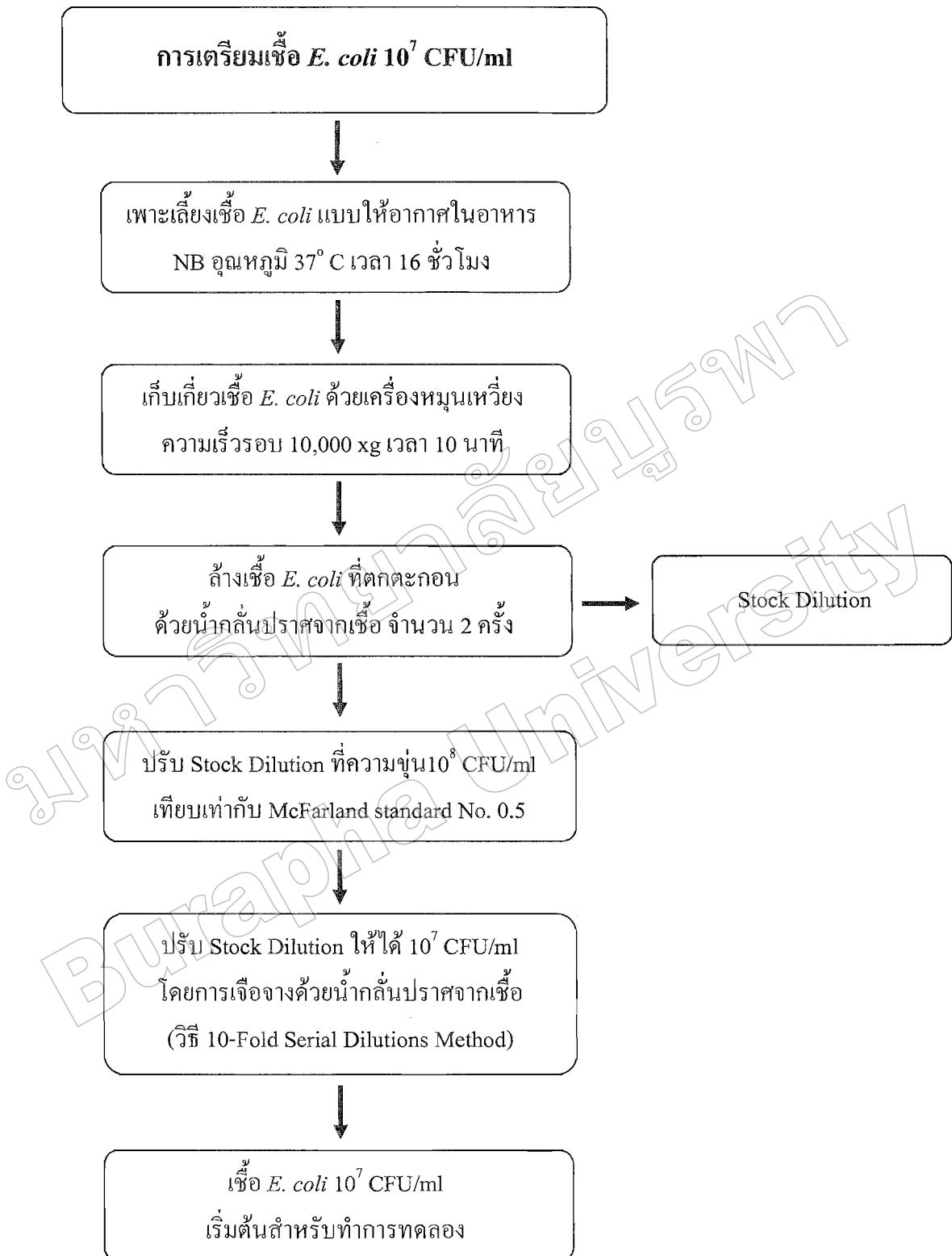
4. การหาความหนาของฟิล์มบางไทเทเนียมโดยอุ่นไฮด์ โดยนำวัสดุรองรับที่เป็นแผ่นซิลิกอนที่ผ่านกระบวนการเคลือบแล้ว ไปวัดความหนาด้วยเครื่อง Atomic Force Microscope โดยใช้เบื้องขนาดเล็กทำจากซิลิกอนในไตรดีเคลือนที่กราดบนผิวฟิล์มบางเพื่อตรวจวัดความหนา

5. การศึกษาลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางไทเทเนียมโดยอุ่นไฮด์ โดยนำวัสดุรองรับที่เป็นแผ่นซิลิกอนที่ผ่านกระบวนการเคลือบแล้วไปวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวด้วยเครื่อง Atomic Force Microscope โดยมีความละเอียดในระดับนาโน และใช้พื้นที่ในการวิเคราะห์เท่ากับ $1 \times 1 \mu\text{m}^2$ พร้อมวัดค่าความหยาบผิว

การศึกษาการม่ำเชื้อ *E. coli* ของฟิล์มนบางไทเทนเนียมไ/doออยไซด์

การศึกษาความสามารถในการม่ำเชื้อ *E. coli* เป็นการนำฟิล์มนบางไทเทนเนียมไ/doออยไซด์ที่เคลือบໄได้ โดยเลือกจากเงื่อนไขที่เหมาะสม มาทดสอบความสามารถในการม่ำเชื้อ ซึ่งในงานวิจัยนี้เลือกใช้เชื้อแบคทีเรีย *Escherichia coli* (*E. coli*) ATCC 25922 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. การเตรียมเชื้อ *E. coli* โดยนำเชื้อ *E. coli* ป่นเม็ดบนอาหารเหลวสำเร็จรูป Nutrient Broth (NB) ปริมาตร 200 ml ในภาชนะปู๊ แบนให้อาศาตนเครื่องเบี้ยงแบบวงกลม 150 rpm ที่อุณหภูมิ 37° C เป็นเวลา 16 ชั่วโมง เก็บเกี่ยวเซลล์ด้วยเครื่องหมุนแหียงแบบควบคุมอุณหภูมิ ความเร็วรอบ 10,000 xg เป็นเวลา 10 นาที (ทำการทดลองด้วยเทคนิคปีลอดเชื้อ และอุปกรณ์ทุกชนิดต้องผ่านการม่ำเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดัน (Autoclave) ที่อุณหภูมิ 121.5° C ความดัน 15 PSI เป็นเวลา 15 นาที และในขณะใช้เครื่องมือเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดัน จะต้องมีเทปสำหรับนึ่ง ม่ำเชื้อ (Autoclave tape) ซึ่งจะมีแถบสีที่จะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีดำหรือน้ำตาลเข้ม เมื่อผ่านการนึ่ง ม่ำเชื้อแล้ว) นำเชื้อ *E. coli* ที่ตกตะกอนมาล้างด้วยน้ำกลันที่ปราศจากเชื้อ จำนวน 2 ครั้ง จะได้ เชื้อ *E. coli* (Stock Solution) สำหรับใช้ในการทดลอง จากนั้นนำ Stock Solution มาปรับความเข้มข้นความชุนของเซลล์ ให้มีค่าประมาณ 10^8 CFU/ml (เทียบเท่ากับ McFarland standard No. 0.5 (O.D. 0.2 ที่ความยาวคลื่น 600 nm)) และนำเซลล์ที่ได้มาทำการปรับความเข้มข้นความชุนให้ได้ 10^7 CFU/ml โดยนำเซลล์มาเจือจางด้วยน้ำกลันปราศจากเชื้อ ด้วยวิธี 10-Fold Serial Dilutions Method ซึ่งขั้นตอนการเตรียมเชื้อ *E. coli* และดังภาพที่ 3-14

ภาพที่ 3-14 ขั้นตอนการเตรียมเชื้อ *E. coli*

2. การทดสอบความสามารถในการฆ่าเชื้อ *E. coli* ของฟิล์มบางไทเทเนียม

โดยออกไซด์ที่เตรียมได้เริ่มต้นนำเซลล์ *E. coli* ความเข้มข้นความชุ่น 10^7 CFU/ml ปริมาตร 100 μ l หยดลงบนบนกระจานที่เคลือบฟิล์มบางไทเทเนียม โดยออกไซด์ และกระจานที่ไม่ผ่านการเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียม โดยออกไซด์ ซึ่งวางอยู่ในงานอาหารเลี้ยงเชื้อ ปิดทับด้วยแผ่น Overhead Film แล้วนำมาย่างแสงอัลตราไวโอเลต พร้อมชุดควบคุมที่ไม่ผ่านการฉายแสงอัลตราไวโอเลต นำตัวอย่างออกมาย่างจาก การฉายแสงอัลตราไวโอเลต และทำการล้างเซลล์ด้วยน้ำกลั่นปราศจากเชื้อ ปริมาตร 9 ml บนเครื่องเบี้ยงเบนวงกลม เป็นเวลา นาน 10 นาที จากนั้นนำตัวอย่างเซลล์เชื้อ *E. coli* แต่ละตัวอย่างมาเจือจางด้วยน้ำกลั่นปราศจากเชื้อด้วยวิธี 10-Fold Serial Dilutions Method อยู่ในช่วง $10^{-1} - 10^{-5}$ และนำเซลล์แต่ละระดับความเจือจาง ปริมาตรชนิดละ 0.1 ml เพาเวลียงบนอาหาร Desoxycholate Agar ด้วยวิธีการ Spread Plate นำไปเป็นท่อญี่ปุ่น 37°C เป็นเวลา นาน 24 ชั่วโมง แล้วนำมารวบรวมนับจำนวนเซลล์ที่รอดตาย โดยใช้วิธีการทางชีวภาพ คือ การนับจำนวนเซลล์ที่มีชีวิต ซึ่งในกรณีที่ตัวอย่างเป็นของเหลวหน่วยในการนับเซลล์ คือ CFU/ml (CFU = colony forming unit) โดยวิธีการที่ใช้ในการคำนวณจำนวนเชื้อ *E. coli* ที่รอดตาย มีดังนี้

$$\text{จำนวนเชื้อ } E. coli (\text{CFU/ml}) = \frac{\text{จำนวนโคลoniที่เกิดขึ้นในงานเดี้ยงเชื้อ} \times \text{ระดับความเจือจาง}}{\text{ปริมาตรของตัวอย่างที่หยดลงไปในงานเดี้ยงเชื้อ}}$$

แต่ละชุดการทดลอง ทำซ้ำจำนวน 4 ครั้ง และเปรียบเทียบผลการทดลองกับชุดควบคุมที่ไม่ஜารับแสงอัลตราไวโอเลต



ภาพที่ 3-15 ขั้นตอนการทดสอบการฆ่าเชื้อ *E. coli*

แนวทางการทดลอง

การทดลองในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยเตรียมฟิล์มบาง ไทเทเนียม ได้ออกไซด์บันกระเจกสไลด์ และแผ่นซิลิกอน ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ จากนั้นนำฟิล์ม ไทเทเนียม ได้ออกไซด์ที่เคลือบได้ไป วิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ และศึกษาสมบัติทางแสงของฟิล์มบาง ไทเทเนียม ได้ออกไซด์ ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งการทดลองออกเป็น 3 การทดลอง โดยแต่ละการทดลองมีขั้นตอนการทดลองสรุปได้ดังนี้

การทดลองที่ 1 การศึกษาผลของระยะห่างระหว่างเปลี่ยนกับวัสดุรองรับ

วัตถุประสงค์ เพื่อหาระยะห่างระหว่างเปลี่ยนกับวัสดุรองรับที่เหมาะสมสำหรับ เคลือบฟิล์มบาง ไทเทเนียม ได้ออกไซด์

1. การเตรียมฟิล์มบาง ไทเทเนียม ได้ออกไซด์ที่ระยะห่างระหว่างเปลี่ยนกับวัสดุรองรับต่าง ๆ ขั้นตอนนี้ เป็นการเคลือบฟิล์มบาง ไทเทเนียม ได้ออกไซด์บันกระเจกสไลด์ และ แผ่นซิลิกอน โดยการประค่าระยะห่างระหว่างเปลี่ยนกับวัสดุรองรับในกระบวนการเคลือบ เพื่อหาระยะห่างระหว่างเปลี่ยนกับวัสดุรองรับที่เหมาะสมสำหรับเคลือบฟิล์มบาง ไทเทเนียม ได้ออกไซด์ ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 3-1

2. การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของฟิล์มบาง ไทเทเนียม ได้ออกไซด์ ขั้นตอนนี้ เป็นการนำฟิล์มบาง ไทเทเนียม ได้ออกไซด์ที่เคลือบ ได้มาศึกษาโครงสร้างผลึกขนาดผลึก ค่าคงที่ แตกต่าง ความหนา และลักษณะพื้นผิว

ตารางที่ 3-1 เงื่อนไขการเคลือบฟิล์มบาง ไทเทเนียม ได้ออกไซด์ ที่ระยะห่างระหว่างเปลี่ยนกับวัสดุรองรับต่าง ๆ

เงื่อนไข	รายละเอียด
เปลี่ยน	ไทเทเนียม (99.97%)
วัสดุรองรับ	กระจกสไลด์ และแผ่นซิลิกอน
ความดันพื้น (mbar)	5.0×10^{-5}
ความดันรวม (mbar)	5.0×10^{-3}
อัตราไนโตรเกสอาร์กอน (sccm)	1
อัตราไนโตรเกสออกซิเจน (sccm)	6
ระยะห่างระหว่างเปลี่ยนกับวัสดุรองรับ (cm)	10, 12, 14, 16, 18

การทดลองที่ 2 การศึกษาผลของอัตราไหลแก๊สออกซิเจน

วัตถุประสงค์ เพื่อหาอัตราไหลแก๊สออกซิเจนที่เหมาะสมสำหรับเคลือบฟิล์มบาง
ไทยเนียม ไดออกไซด์

1. การเตรียมฟิล์มบาง ไทยเนียม ไดออกไซด์ที่อัตราไหลแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ ขั้นตอนนี้
เป็นการเคลือบฟิล์มบาง ไทยเนียม ไดออกไซด์บนกระจกใส่และแผ่นซิลิกอน โดยการประค่า
อัตราไหลแก๊สออกซิเจนในกระบวนการเคลือบ เพื่อหาอัตราไหลแก๊สออกซิเจนที่เหมาะสมสำหรับ
เคลือบฟิล์มบาง ไทยเนียม ไดออกไซด์ ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 3-2

2. การวิเคราะห์ลักษณะพารามิตภาพของฟิล์มบาง ไทยเนียม ไดออกไซด์ ขั้นตอน
นี้เป็นการนำฟิล์มบาง ไทยเนียม ไดออกไซด์ที่เคลือบไดมาศึกษาโครงสร้างผิว ขนาดผิว
ค่าคงที่เดททิช ความหนา และลักษณะพื้นผิว

ตารางที่ 3-2 เส้นทางการเคลือบฟิล์มบาง ไทยเนียม ไดออกไซด์ที่อัตราไหลแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ

เงื่อนไข	รายละเอียด
เป้าสารเคลือบ	ไทยเนียม (99.97%)
วัสดุรองรับ	กระจกใส่ และแผ่นซิลิกอน
ความดันพื้น (mbar)	5.0×10^{-5}
ความดันรวม (mbar)	5.0×10^{-3}
ระยะระหว่างเป้าสารเคลือบถึงวัสดุรองรับ (cm)	12
อัตราไหลแก๊สออกซิเจน (sccm)	1
อัตราไหลแก๊สออกซิเจน (sccm)	2, 4, 6

การทดลองที่ 3 การศึกษาการฆ่าเชื้อ *E. coli* ของฟิล์มบางไทเทเนียมโดยออกไซด์วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสามารถในการฆ่าเชื้อ *E. coli* ของฟิล์มบางไทเทเนียมโดยออกไซด์ที่เตรียมได้

1. การเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมโดยออกไซด์ที่มีโครงสร้างผลึกแบบอนาแทส โดยเลือกจากเงื่อนไขที่เหมาะสมจากการทดลองในตอนที่ 1 และ 2

2. การทดสอบการฆ่าเชื้อ *E. coli* ของฟิล์มบางไทเทเนียมโดยนำฟิล์มบางที่เคลือบได้มาทดสอบความสามารถในการฆ่าเชื้อ *E. coli* เมื่อถูกกระตุนด้วยการฉายแสงอัลตราไวโอล็อก เปรียบเทียบผลการทดลองกับชุดควบคุมที่ไม่ผ่านการฉายแสงอัลตราไวโอล็อก โดยการนับจำนวนโคโลนีของเชื้อ *E. coli* ที่รอดตาย ในหน่วย CFU/ml

ตารางที่ 3-3 เงื่อนไขการเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมโดยออกไซด์ สำหรับการทดสอบความสามารถในการฆ่าเชื้อ *E. coli*

เงื่อนไข	รายละเอียด
เป้าสารเคลือบ	ไทเทเนียม (99.97%)
วัสดุรองรับ	กระจกสไลด์
ความดันพื้น (mbar)	5.0×10^{-5}
ความดันรวม (mbar)	5.0×10^{-3}
อัตราไหหลักอาร์กอน (sec cm)	1
อัตราไหหลักออกซิเจน (sccm)	6
ระยะระหว่างเป้าสารเคลือบถึงวัสดุรองรับ (cm)	12